

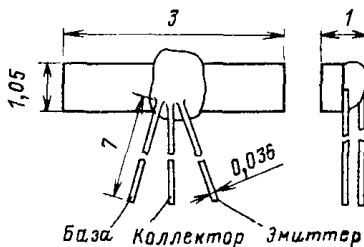
2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2, КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* переключа-
тельные высокочастотные маломощные

Предназначены для примене-
ния в схемах переключения

Бескорпусные, на кристалло-
держателе, с гибкими выводами
и защитным покрытием Выпус-
каются в индивидуальной сопро-
водительной таре Обозначение
типа приводится на сопроводитель-
ной таре

Масса транзистора не более
0,006 г



Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 2$ В, $I_Э = 10$ мА не ме-
нее 250 МГц
типичное значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 350* МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 2$ В,
 $I_Э = 5$ мА, $f = 5$ МГц не более 500 пс
типичное значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 120* пс

Время рассасывания при $I_К = 100$ мА, $I_{Б1} = I_{Б2} = 10$ мА
не более :

2Т364А-2	100 нс
2Т364Б-2	130 нс
КТ364А-2	150 нс
2Т364В-2	160 нс
КТ364Б-2	180 нс
КТ364В-2	230 нс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с об-
щим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 100$ мА

при $T = 298$ К

2Т364А-2, КТ364А-2	20 — 70
2Т364Б-2, КТ364Б-2	40 — 120
2Т364В-2, КТ364В-2	80 — 240

при $T = 213$ К

2Т364А-2	От 0,3 значения при $T = 298$ К до 70
2Т364Б-2	От 0,3 значения при $T = 298$ К до 120
2Т364В-2	От 0,3 значения при $T = 298$ К до 240

при $T = 358$ К

2Т364А-2	От 20 до 2,5 значений при $T = 298$ К
2Т364Б-2	От 40 до 2,5 значений при $T = 298$ К

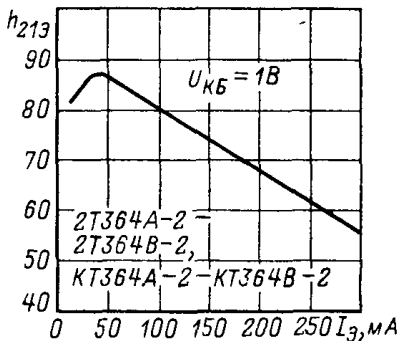
Материал взят из источника:

2Т364В-2 От 40 до 2,5 значений при $T = 298 \text{ К}$

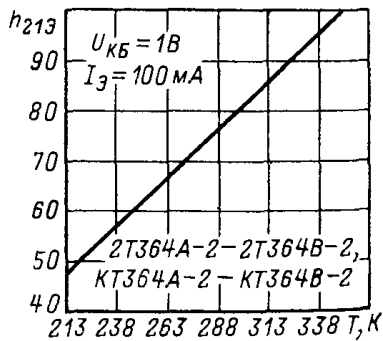
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 100 \text{ мА}$, $I_B = 10 \text{ мА}$ не более	0,3 В
типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2	0,15* В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 100 \text{ мА}$, $I_B = 10 \text{ мА}$ не более	1,1 В
типовое значение 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2	0,9* В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 25 \text{ В}$ не более:	
при $T = 298 \text{ К}$	1 мкА
при $T = 358 \text{ К}$	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$ не более:	
при $T = 298 \text{ К}$	1 мкА
при $T = 358 \text{ К}$	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ не более	15 пФ
типовое значение	7* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ не более	30 пФ
типовое значение	14* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	25 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$	20 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	200 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$	400 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 298 \text{ К}$	30 мВт
при $T = 358 \text{ К}$	12 мВт
Общее тепловое сопротивление	3300 К/Вт
Температура перехода	398 К



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры.

Материал взят из источника:

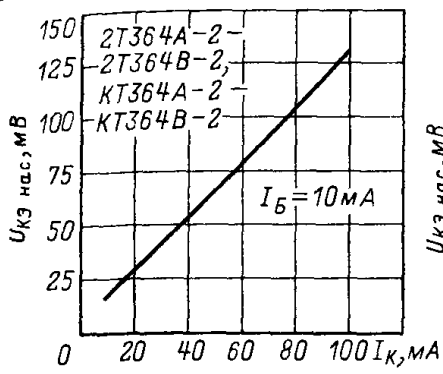
Температура окружающей среды:

2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2 От 213 до 358 К

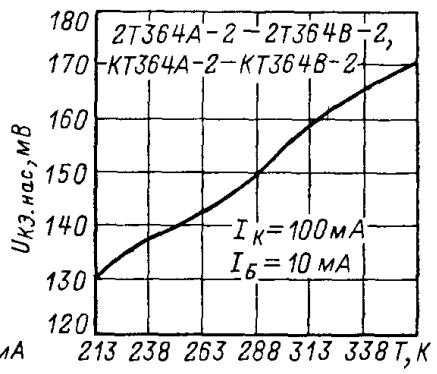
КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 От 233 до 358 К

Температура окружающей среды при транспортировке в заводской упаковке КТ364А-2, КТ364Б-2,

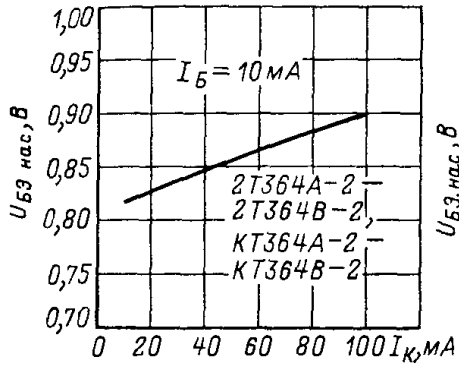
КТ364В-2 От 223 до 358 К



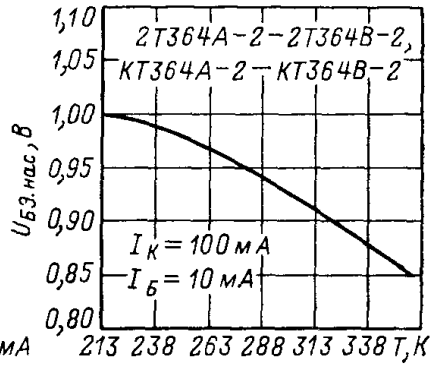
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985